

性能特点

- 频率范围: 2 GHz - 20 GHz
- 小信号增益: 19 dB
- 噪声系数: 2.5 dB
- P1dB: 16 dBm@10GHz
- 直流供电: $V_d=5\text{ V}@I_d=68\text{ mA}$
- 芯片尺寸: 3.15 mm×1.30 mm×0.07 mm

产品简介

ADIC210是一款超宽带低噪声放大器芯片，频率范围覆盖2 GHz-20 GHz，小信号增益典型值为19 dB，噪声系数典型值为2.5 dB。该芯片+5 V单电源供电。

键合压点定义

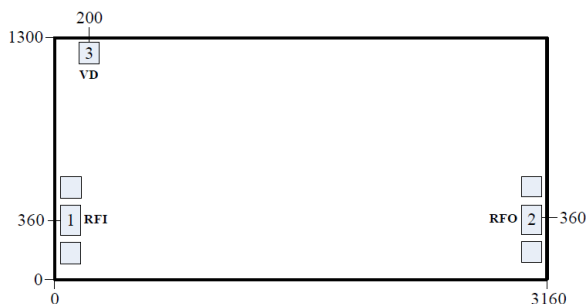
编号	符号	功能描述	尺寸(μm^2)
1	RFin	射频信号输入端, 外接50欧姆系统, 无需隔直电容	120×90
2	RFout	射频信号输出端, 外接50欧姆系统, 无需隔直电容	120×90
3	Vd	漏极电压馈电端, 需外置100 pF和 0.01 μF 旁路电容	100×100

电性能表 ($T_A = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_d = 5\text{ V}$, $I_d = 68\text{ mA}$)

极限参数

漏极正电压	+8 V
输入功率	10 dBm
存储温度	-65 °C~150 °C
使用温度	-55 °C~85 °C
最高工作沟道温度	175 °C

外形尺寸



- 注：1) 所有标注尺寸单位为微米(μm)；
2) 外形长宽尺寸公差： $\pm 50\ \mu\text{m}$ ；
3) 芯片厚度 $70\ \mu\text{m}$ 。



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

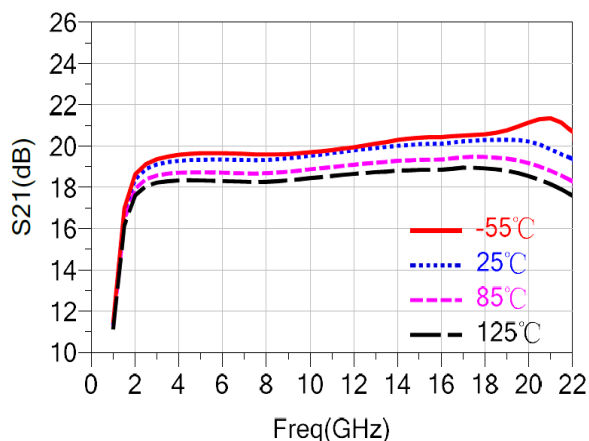
参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	2		20	GHz
小信号增益		19		dB
增益平坦度		±0.5		dB
噪声系数		2.5		dB
P1dB		16		dBm
输入回波损耗		1.3		-
输出回波损耗		1.5		-
静态电流		68		mA



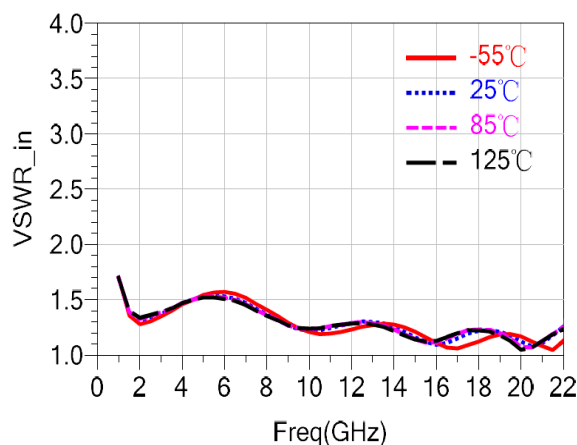
关注公众号

在片测试曲线 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_d = 5\text{ V}$, $I_d = 68\text{ mA}$)

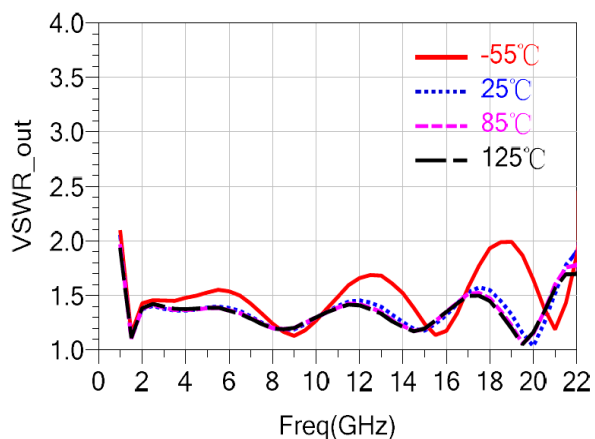
小信号增益 vs. 频率 vs. 温度



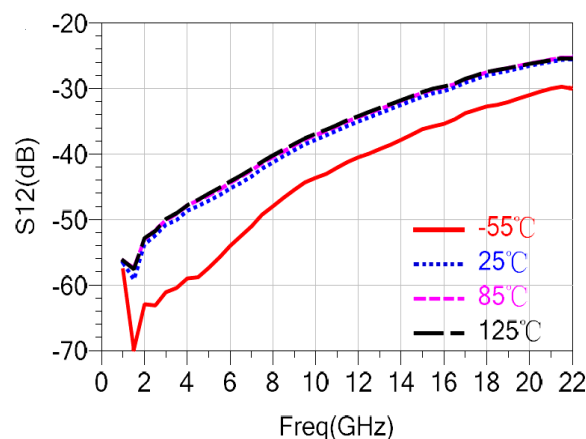
输入驻波 vs. 频率 vs. 温度



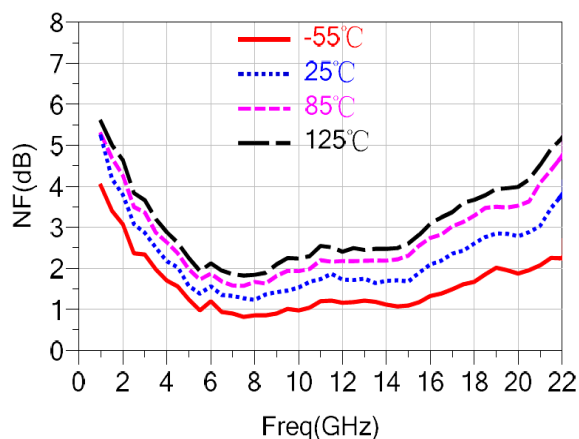
输出驻波 vs. 频率 vs. 温度



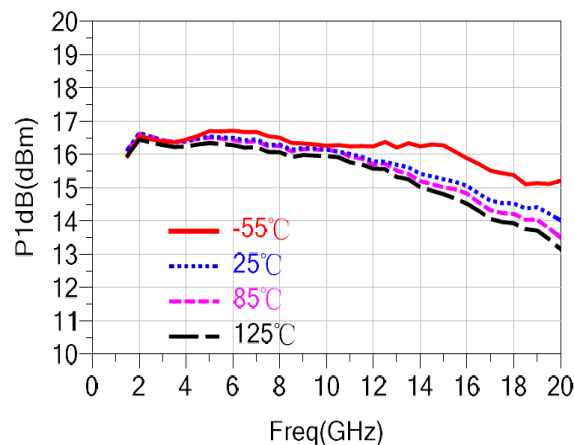
反向隔离度 vs. 频率 vs. 温度



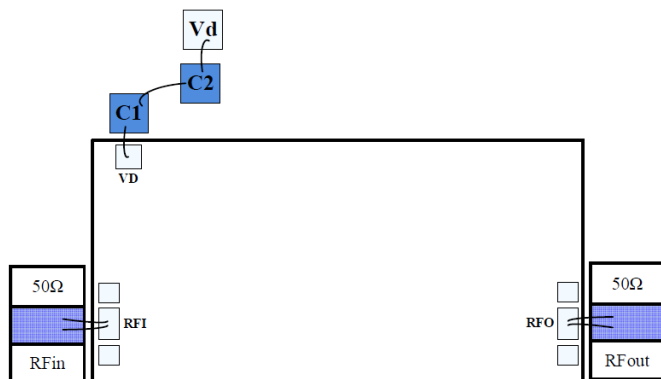
噪声系数 vs. 频率 vs. 温度



输出 P_{1dB} vs. 频率 vs. 温度



建议装配图



注:

外围电容C1容值为100 pF, C2容值为0.01 uF, 其中C1推荐使用单层电容, 并尽量靠近芯片键合压点。

注意事项

- 1.存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
- 2.清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。
- 3.静电防护: 请严格遵守ESD防护要求, 避免静电损伤。
- 4.常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。
- 5.加电顺序: 加电时, 先加栅压, 后加漏压; 去电时, 先去漏压, 后去栅压。
- 6.装架操作: 芯片安装可采用AuSn焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺, 安装面必须清洁平整, 芯片与输入输出射频连接线基板的缝隙尽量小。
- 7.烧结工艺: 用80/20 AuSn烧结, 烧结温度不能超过300 °C, 烧结时间尽量短, 不要超过20秒, 摩擦时间不要超过3秒。
- 8.粘接工艺: 导电胶粘接时点胶量尽量少, 固化条件参考导电胶厂商提供的资料。
- 9.键合操作: 无特殊说明, 射频输入输出用2根键合丝(直径25 μm金丝), 键合线尽量短。热超声键合温度150 °C, 采用尽可能小的超声能量。球形键合劈刀压力40~50 gf, 楔形键合劈刀压力18~22 gf。
- 10.有问题请与供货商联系。